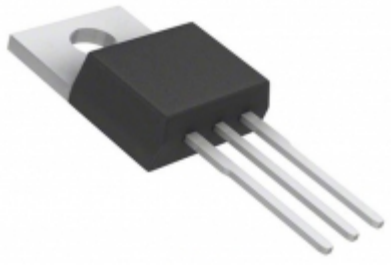

	<h2 style="color: red;">FDP10N60NZ</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP10N60NZ</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP10N60NZ.pdf</a> <a href="#">2.FDP10N60NZ.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 28663 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP10N60NZ
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28663 pcs Stock
Serie	UniFET-II™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	185W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1475pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

FDP10N60NZ ist neu im Original, Suche FDP10N60NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP10N60NZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP10N60NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP120AN15AO</b> VB FDP120AN15AO VB</p>	 <p><b>FDP120AN15A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP11N50</b> FSC FSC TO-220</p>	 <p><b>FDP100N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p>
 <p><b>FDP10AN06A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP10AN06A0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP120N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 74A TO-220</p>	 <p><b>FDP10N60NZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FDP060AN08A0	↔ FDP060AN08A0	⇒ FDP060AN08A0	D FDP060N08A0	⇒ FDP060N08A0
⊣ FDP068AN08A0	⊗ FDP070AN06A0	D FDP070AN06A0	⇒ FDP070AN06A0	⇒ FDP075N15A
⊗ FDP075N15A	⊣ FDP083N15A	⊗ FDP083N15A	↔ FDP083N15A_F102	⇒ FDP085N10A
D FDP085N10A	⊗ FDP085N10A_F102	⊣ FDP090N10	⊗ FDP090N10	⇒ FDP100N10
⇒ FDP100N10	↔ FDP10AN06A0	⊗ FDP10AN06A0	⊣ FDP10AN06A0	⇒ FDP10N60NZ
↔ FDP120AN15A0	⇒ FDP120AN15A0	D FDP120AN15A0	⊗ FDP120N10	⊣ FDP120N10
⊗ FDP12N50	D FDP12N50	⇒ FDP12N50NZ	↔ FDP12N50NZ	⇒ FDP12N60NZ
⊣ FDP12N60NZ	⊗ FDP13AN06A0	↔ FDP13AN06A0	⇒ FDP13AN06A0	⇒ FDP14AN06LA0
⊗ FDP14AN06LA0	⊣ FDP14AN06LA0	⊗ FDP14N60	D FDP150N10	⇒ FDP150N10
↔ FDP150N10A	⊗ FDP150N10A	⊣ FDP150N10A_F102	⊗ FDP15N40	⇒ FDP15N40

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited